

## RFT SY330/1 ... 20

### Schnelle Silizium- Gleichrichterdiode im Kunststoffgehäuse

Typ	$U_{RRM}^{1)}$ (V)	$U_{RSM}^{2)}$ (V)	$U_R$ (V)	$I_{F(AV)}^{3)}$ (A)	$I_{FSM}^{4)}$ (A)
SY330/1	100	100	100	≤ 0,48  bis  ≤ 0,29	≤ 20
2	200	200	150		
4	400	400	350		
6	600	600	500		
8	800	800	700		
10	1000	1000	900		
12	1200	1200	1100		
15	1500	1500	1400		
18	1800	1800	1600		
20	2000	2000	1800		

Empfohlene  $U_{RWM} \leq 0,7 \times U_{RRM}$   
 Sperrschichttemperatur = -55 bis 160°C  
 Sperrholungszeit  $t_{rr} \leq 0,25 \mu s$   
 für  $I_F = 1A$ ,  
 $dI_F/dt = -25A/\mu s$ ,  
 $I_R = 0,4A$ ,  $\vartheta_j = 25^\circ C$

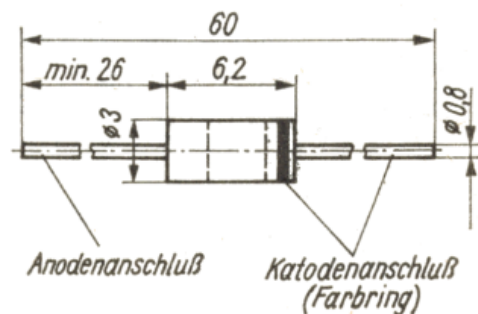
<sup>1)</sup>  $t_p$  von  $U_R \leq 0,5$ ,  $f = 50Hz \dots 30kHz$   
 $T$

<sup>2)</sup>  $t_p \leq 20mS$

<sup>3)</sup> Sinushalbwellen,  $f = 50Hz \dots 30kHz$ , volle Drahtlänge auf Leiterplatte,  $\vartheta_a = 45^\circ C$

<sup>4)</sup> Sinushalbwellen,  $f \geq 50Hz$ ,  $\vartheta_j = 100^\circ C$ ,  $U_R = 0$

Drahtanschlüsse beiderseitig  
 bis auf 1,5mm Abstand vom  
 Gehäuse lötfähig verzinkt



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985

Datasheet Rev. 1.3 – 04/19 – data without warranty / liability